

M2TKI-50-12ЧШ

**IGBT
модули**

www.elvpr.ru

СИЛОВОЙ IGBT МОДУЛЬ

- ◆ полумост
- ◆ корпус с изолированным основанием
- ◆ низкое значение энергий коммутационных потерь при включении E_{on} и выключении E_{rec}
- ◆ оптимальные частоты коммутации до 50 кГц
- ◆ встроенный быстродействующий SiC диод обратного тока

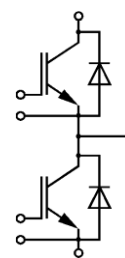


ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- ◆ преобразователи частоты
- ◆ источники бесперебойного питания
- ◆ сварочное оборудование
- ◆ оборудование для индукционного нагрева

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

- ◆ $V_{CES} = 1200 \text{ В}$
- ◆ $I_C = 50 \text{ А}$ ($T_C = 70 \text{ °C}$)
- ◆ $V_{CEsat} = 3.2 \text{ В}$ (тип.)
- ◆ $I_{Cpuls} = 75 \text{ А}$ ($T_C = 70 \text{ °C}$)



МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ

Наименование параметра	Условное обозначение	Значение параметра	Единица измерения
Напряжение коллектор-эмиттер	V_{CE}	1200	В
Напряжение затвор-эмиттер	V_{GE}	± 20	
Постоянный ток коллектора	I_C	при $T_C = 25 \text{ °C}$	А
		при $T_C = 70 \text{ °C}$	
Импульсный ток коллектора ($t_p = 1 \text{ мс}$, $T_C = 70 \text{ °C}$)	I_{Cpuls}	100	ВТ
Постоянный прямой ток, диод обратного тока	I_F	50	
Повторяющийся импульсный прямой ток, диод обратного тока	I_{FRM}	100	
Суммарная мощность рассеивания (на один ключ, $T_C = 25 \text{ °C}$), IGBT	P_{tot}	400	°C
Максимальная температура перехода	T_j	+ 150	
Температура хранения	T_{stg}	- 40...+ 125	В (эфф)
Напряжение изоляции ($t = 1 \text{ мин.}$)	V_{isol}	2500	

ТЕПЛОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Тепловое сопротивление переход-корпус, IGBT (на один ключ)	R_{thjc}	≤ 0.3	°C/Вт
Тепловое сопротивление переход-корпус, диод обратного тока (на один ключ)	R_{thjcD}	≤ 0.8	
Тепловое сопротивление корпус-охладитель, $\lambda_{paste} = 1 \text{ Вт/м} \cdot \text{°C}$, на модуль (типичное значение)	R_{thck}	0.03	°C/Вт

М2ТКИ-50-12ЧШ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (при 25 °С, если не указано иное значение)

Наименование параметра	Условное обозначение	Значение параметра			Единица измерения
		мин.	тип.	макс.	
Статические характеристики					
Пороговое напряжение затвор-эмиттер ($V_{GE} = V_{CE}$, $I_C = 2 \text{ mA}$)	$V_{GE(th)}$	4.5	5.5	6.5	В
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер ($V_{GE} = 15 \text{ V}$, $I_C = 50 \text{ A}$)	V_{CEsat}	-	3.2	3.75	
при $T_j = 25 \text{ °C}$		-	3.85	-	
при $T_j = 125 \text{ °C}$					
Ток утечки коллектор-эмиттер ($V_{CE} = 1200 \text{ V}$, $V_{GE} = 0 \text{ V}$) при $T_j = 25 \text{ °C}$	I_{CES}	-	-	5.0	мА
Ток утечки затвор-эмиттер ($V_{GE} = 20 \text{ V}$, $V_{CE} = 0 \text{ V}$)	I_{GES}	-	-	400	нА
Заряд затвора ($V_{GE} = \pm 15 \text{ V}$)	Q_G	-	0.6	-	мкКл
Характеристики на переменном токе					
Входная емкость ($V_{CE} = 25 \text{ V}$, $V_{GE} = 0 \text{ V}$, $f = 1 \text{ МГц}$)	C_{ies}	-	3.4	-	нФ
Обратная переходная емкость ($V_{CE} = 25 \text{ V}$, $V_{GE} = 0 \text{ V}$, $f = 1 \text{ МГц}$)	C_{res}	-	0.21	-	
Характеристики переключения (индуктивная нагрузка, при $T_j = 125 \text{ °C}$)					
Время задержки включения ($V_{CE} = 600 \text{ V}$, $V_{GE} = \pm 15 \text{ V}$, $I_C = 50 \text{ A}$, $R_G = 13 \text{ Ом}$) при $T_j = 25 \text{ °C}$ при $T_j = 125 \text{ °C}$	$t_{d(on)}$	-	205	-	нс
		-	215	-	
Время нарастания ($V_{CE} = 600 \text{ V}$, $V_{GE} = \pm 15 \text{ V}$, $I_C = 50 \text{ A}$, $R_G = 13 \text{ Ом}$) при $T_j = 25 \text{ °C}$ при $T_j = 125 \text{ °C}$	t_r	-	50	-	
		-	55	-	
Время задержки выключения ($V_{CE} = 600 \text{ V}$, $V_{GE} = \pm 15 \text{ V}$, $I_C = 50 \text{ A}$, $R_G = 13 \text{ Ом}$) при $T_j = 25 \text{ °C}$ при $T_j = 125 \text{ °C}$	$t_{d(off)}$	-	230	-	
		-	245	-	
Время спада ($V_{CE} = 600 \text{ V}$, $V_{GE} = \pm 15 \text{ V}$, $I_C = 50 \text{ A}$, $R_G = 13 \text{ Ом}$) при $T_j = 25 \text{ °C}$ при $T_j = 125 \text{ °C}$	t_f	-	130	-	
		-	170	-	



М2ТКИ-50-12ЧШ

Наименование параметра	Условное обозначение	Значение параметра			Единица измерения
		мин.	тип.	макс.	
Энергия потерь при включении ($V_{CE} = 600 \text{ В}$, $V_{GE} = \pm 15 \text{ В}$, $I_C = 50 \text{ А}$, $R_G = 13 \text{ Ом}$, $L_S = 30 \text{ нГн}$, за один импульс) при $T_j = 25 \text{ °C}$ при $T_j = 125 \text{ °C}$	E_{on}	- -	2.0 2.7	- -	мДж
Энергия потерь при выключении ($V_{CE} = 600 \text{ В}$, $V_{GE} = \pm 15 \text{ В}$, $I_C = 50 \text{ А}$, $R_G = 13 \text{ Ом}$, $L_S = 30 \text{ нГн}$, за один импульс) при $T_j = 25 \text{ °C}$ при $T_j = 125 \text{ °C}$	E_{off}	- -	1.5 2.5	- -	
Ток короткого замыкания ($t_p \leq 10 \text{ мкс}$, $V_{CC} = 900 \text{ В}$, $V_{GE} = \pm 15 \text{ В}$, $V_{CEmax} = V_{CES} - L_{\sigma(CE)} \times di/dt$, $T_j = 125 \text{ °C}$)	I_{SC}	-	300	-	А
Внутренняя индуктивность модуля по цепи коллектор-эмиттер	$L_{\sigma(CE)}$	-	30	-	нГн

Характеристики диода обратного тока

Прямое падение напряжения ($I_F = 50 \text{ А}$, $V_{GE} = 0 \text{ В}$) при $T_j = 25 \text{ °C}$ при $T_j = 125 \text{ °C}$	V_F	- -	1.50 2.10	2.00 -	В
Ток обратного восстановления ($I_F = 50 \text{ А}$, $V_{GE} = -15 \text{ В}$, $V_R = 600 \text{ В}$, $di_F/dt = -1450 \text{ А/мкс}$) при $T_j = 25 \text{ °C}$ при $T_j = 125 \text{ °C}$	I_{RM}	- -	20 20	- -	А
Время обратного восстановления ($I_F = 50 \text{ А}$, $V_{GE} = -15 \text{ В}$, $V_R = 600 \text{ В}$, $di_F/dt = -1450 \text{ А/мкс}$, $T_j = 125 \text{ °C}$)	t_{rr}	-	25	-	нс
Заряд обратного восстановления ($I_F = 50 \text{ А}$, $V_{GE} = -15 \text{ В}$, $V_R = 600 \text{ В}$, $di_F/dt = -1450 \text{ А/мкс}$) при $T_j = 25 \text{ °C}$ при $T_j = 125 \text{ °C}$	Q_{rr}	- -	0.28 0.30	- -	мкКл
Энергия потерь обратного восстановления ($I_F = 50 \text{ А}$, $V_{GE} = -15 \text{ В}$, $V_R = 600 \text{ В}$, $di_F/dt = -1450 \text{ А/мкс}$) при $T_j = 25 \text{ °C}$ при $T_j = 125 \text{ °C}$	E_{rec}	- -	0.20 0.30	- 0.60	мДж

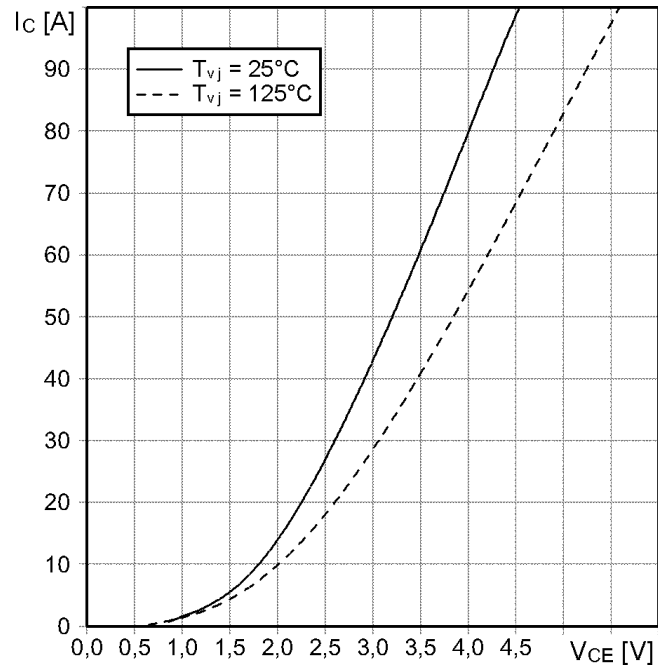


М2ТКИ-50-12ЧШ

Типовые выходные характеристики

$$I_C = f(V_{CE})$$

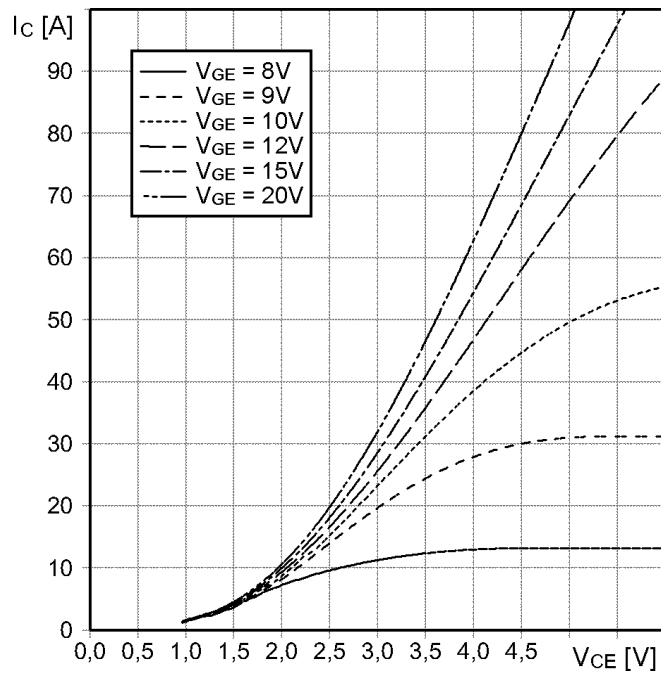
Режим измерения: $V_{GE} = +15\text{ В}$, $T_j = 25, 125\text{ }^\circ\text{C}$



Типовые выходные характеристики

$$I_C = f(V_{CE})$$

Режим измерения: $T_j = 125\text{ }^\circ\text{C}$



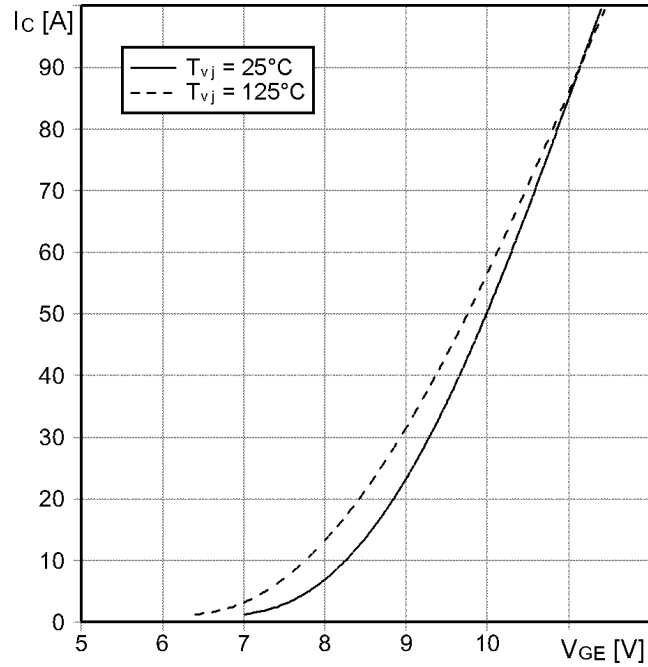


М2ТКИ-50-12ЧШ

Типовые передаточные характеристики

$$I_C = f(V_{GE})$$

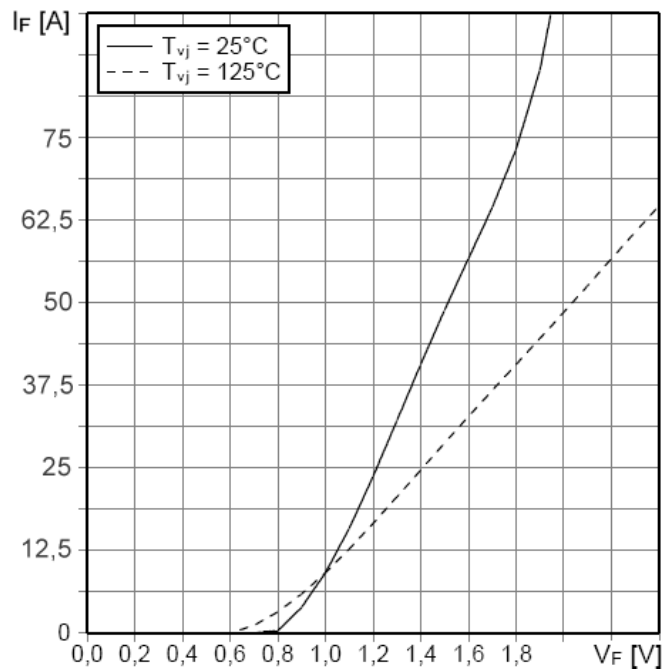
Режим измерения: $V_{CE} = 20 \text{ В}$, $T_j = 25, 125 \text{ }^\circ\text{C}$



Типовые прямые характеристики диода обратного тока

$$I_F = f(V_F)$$

Режим измерения: $T_j = 25, 125 \text{ }^\circ\text{C}$



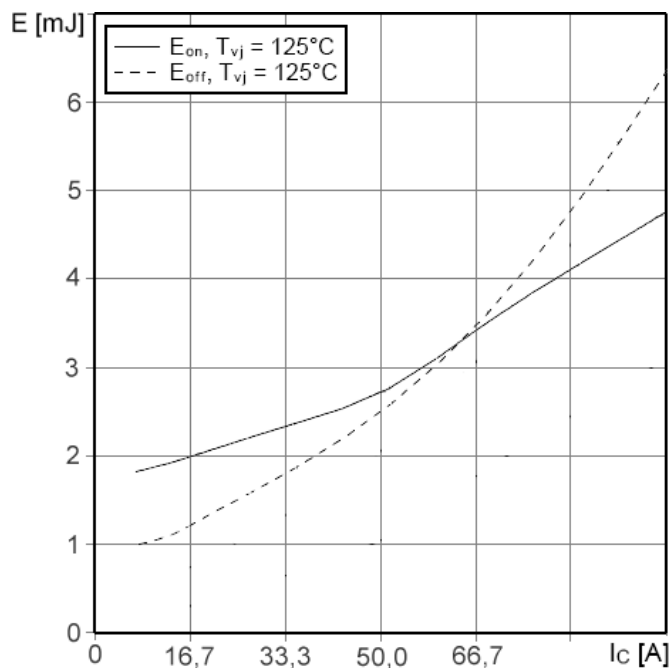


М2ТКИ-50-12ЧШ

Типовые зависимости коммутационных потерь

$E_{off} = f(I_C)$, $E_{on} = f(I_C)$, индуктивная нагрузка

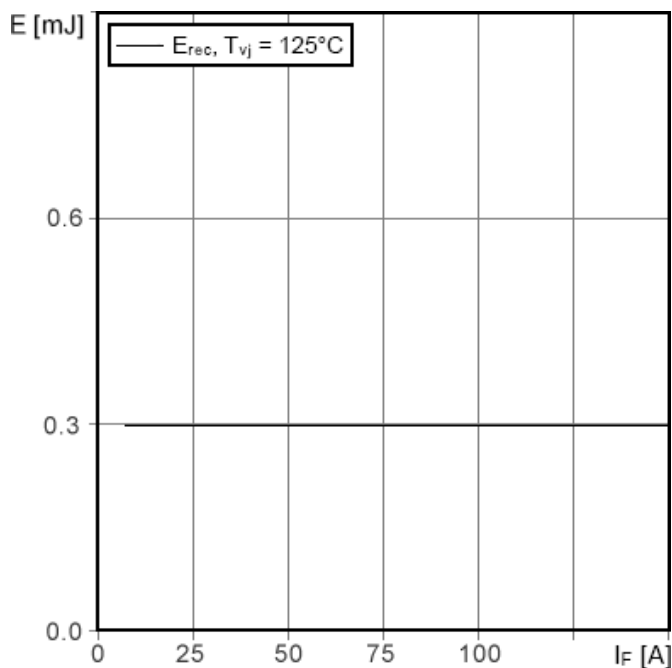
Режим измерения: $V_{CE} = 600$ В, $V_{GE} = \pm 15$ В, $R_{G(on)} = 13$ Ом, $R_{G(off)} = 13$ Ом, $T_j = 125$ °С



Типовая зависимость коммутационных потерь

$E_{rec} = f(R_G)$, индуктивная нагрузка

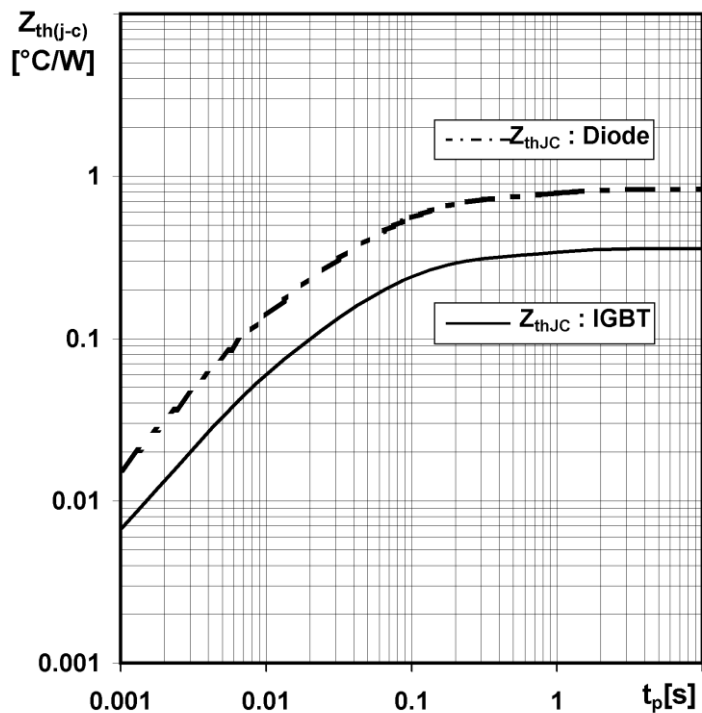
Режим измерения: $V_{CE} = 600$ В, $V_{GE} = \pm 15$ В, $T_j = 125$ °С





М2ТКИ-50-12ЧШ

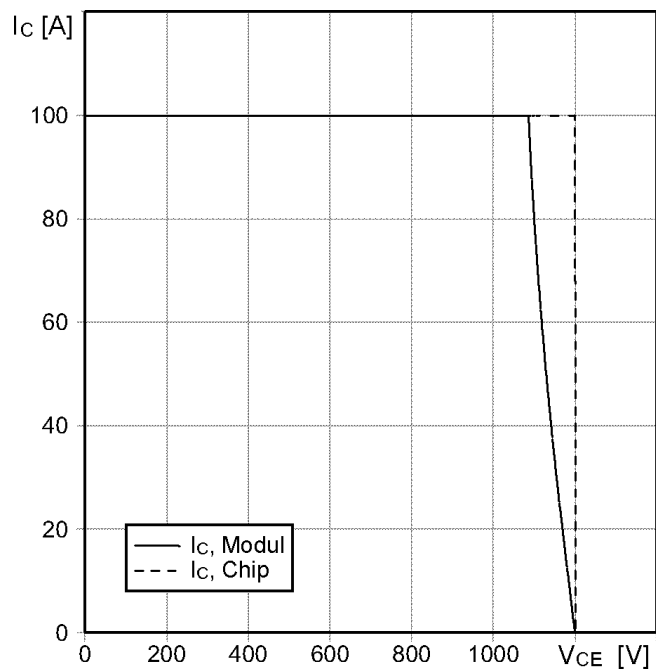
Переходное тепловое сопротивление на IGBT, диоде обратного тока
 $Z_{thjc} = f(t_p)$



Обратная область безопасной работы

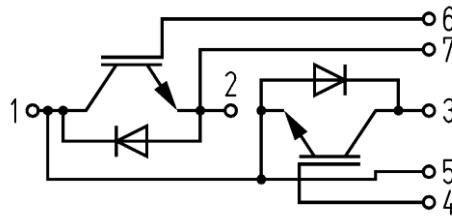
$$I_{C\text{ puls}} = f(V_{CE})$$

Режим измерения: $R_{G(off)} = 13$ Ом, $V_{LF} = V_{LR} = 15$ В, $T_j = 125$ $^{\circ}C$

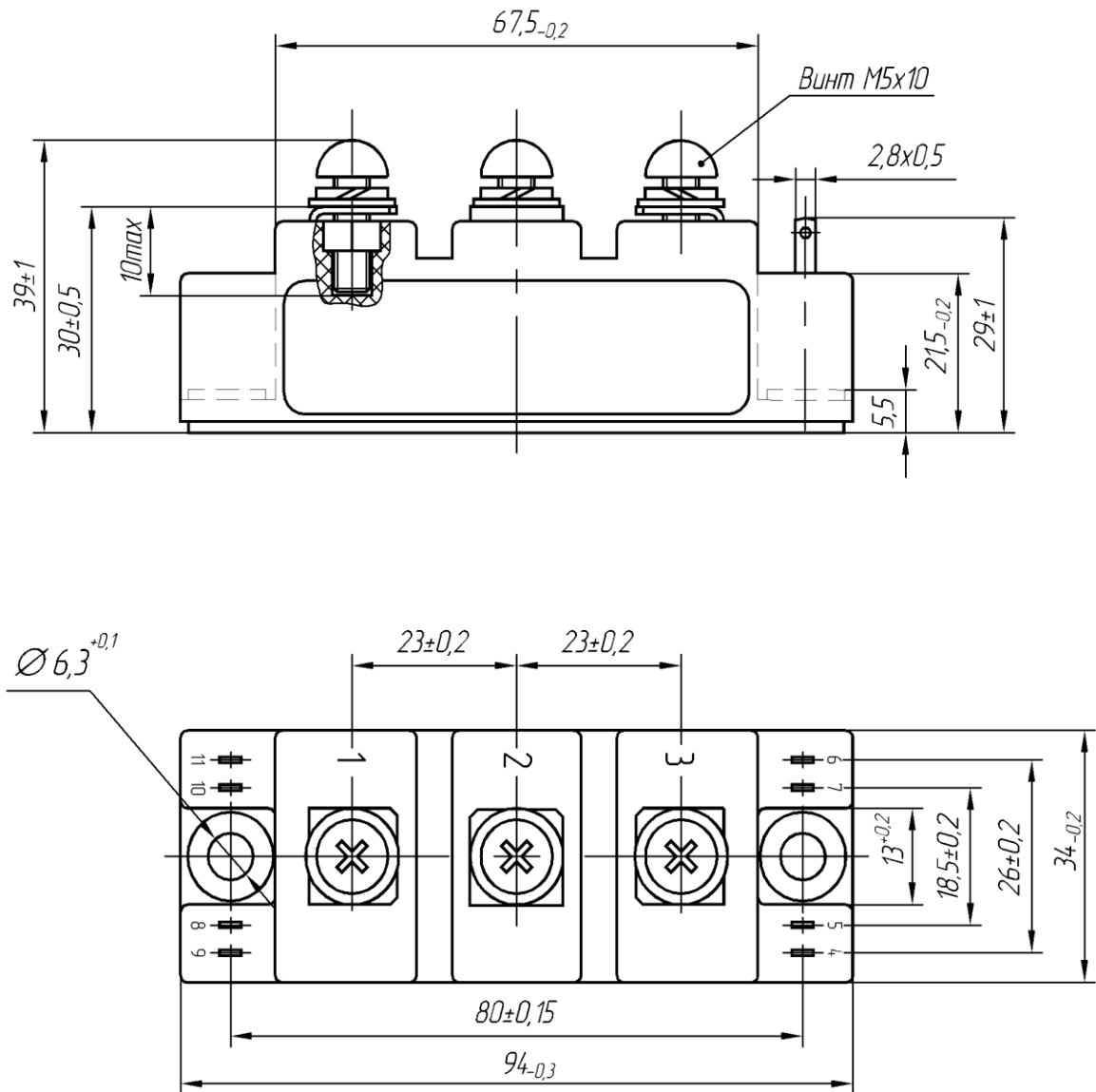


М2ТКИ-50-12ЧШ

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ



ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ



Масса 0.165 кг